

## Bencent GDT ガスアレスタ



### FEATURES 特性 :

- \* SMD タイプ (3 端子 / 4 端子), 複合素子 アレイタイプ, 用途に合わせた特殊形状
- \* High Current Handling Capaility: 10,000A @ 8/20 $\mu$ s
- \* Low Capacitance & Insertion Loss 静電容量 : 1.5pF 以下 @1MHz
- \* Insulation Resistance 絶縁抵抗値 : 1G $\Omega$  以上 @100VDC
- \* Quick Responce & Long Service Life 高速応答性 & 長寿命
- \* Moisture Sensitivity Level 耐湿性レベル : Level 1

### APPROVALS 安全規格 :



GDT Array (アレイ タイプ)



用途に合わせた特殊形状



High current GDT  
高圧用 GDT

複合素子による省スペース化

仕様例 :

品番	直流放電 開始電圧	許容差	インパルス 放電開始電圧	インパルス 放電電流耐量	絶縁抵抗	キャパシタンス (静電容量)
Part Number	DC Breakdown Voltage (*1)	Tolerance of Vs	Impulse Spark-over Voltage 1kV/ $\mu$ s	Impulse Discharge Current (*2) (*3) 8/20 $\mu$ s	Insulation Resistance G $\Omega$ DC	Capacitance (*4) (1MHz)
	100V/s					
B3D230M-CD	230V	$\pm 20\%$	99% $\leq$ 450V	10,000A	$\geq 1$ 100V	$\leq 1.5$ pF

(\*1) The parameters of all are tested by ITU-T K12

(\*2) Total Impulse Discharge Current 10,000A @ 8/20 $\mu$ s by IEC 61000-4-5, 10 shots

(\*3) Currents through center electrode, half value through each line electrode

(\*4) The capacitance are tested by 1MHz

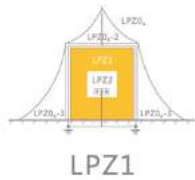
全パラメータは ITU-T K12 にて試験

総インパルス放電電流 : 10,000A @8/20 $\mu$ s (IEC 61000-4-5, 10回 印可)

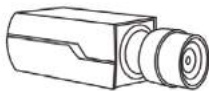
インパルス放電電流が 中央電極に印可される場合は 各ライン電極の半分になります

キャパシタンス (静電容量) は 1MHz にて測定

### Solution の 提案例

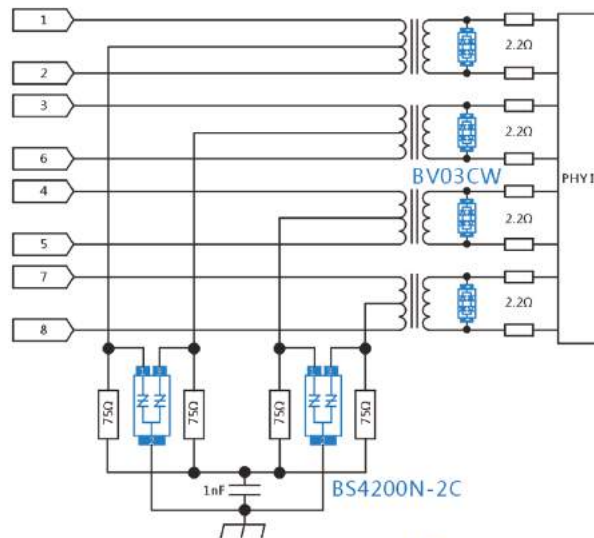


LPZ1



IEC61000-4-5 : 2014  
10/700 $\mu$ s-5/320 $\mu$ s  
CM 6KV-150A  
DM 2KV-50A

### Gigabit Ethernet



- SMT operating efficiency improved
- Save 50% PCB space

Image	Size L*W*H (mm)	VDRM	IDRM	VS	IS	IH	Co
		(V)	25 $^{\circ}$ C( $\mu$ A)	(V)	(mA)	(mA)	(pF)
	5.4x3.3x2	400	5	520	800	$\leq 50$	35
Image	Size L*W*H(mm)	IDRM@ VDRM	VBR@ IR	Vc@Ipp 1A	Capacitance (1MHz)		
		0.5uA@3V	3.5V@1mA	5.8V	$\leq 1.5$ pF		
	2.5x1.28x1.17						